

# 2SB54

# ゲルマニウムPNP合金接合形トランジスタ GERMANIUM PNP ALLOY JUNCTION TRANSISTOR

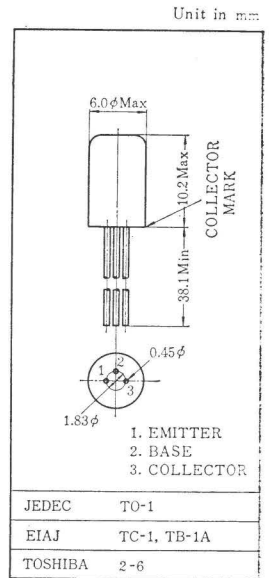
## ○低周波電圧増幅用

### ○ Audio Voltage Amplifier Applications.

- 1 kHz の電力利得が 45dB( Min. ) 得られます。
- 2SB56 B級プッシュプル回路の励振用に適します。
- Recommended for Driver Stage of 2SB56 Class B PushPull Amplifier.

## 最大定格 MAXIMUM RATINGS (Ta=25°C)

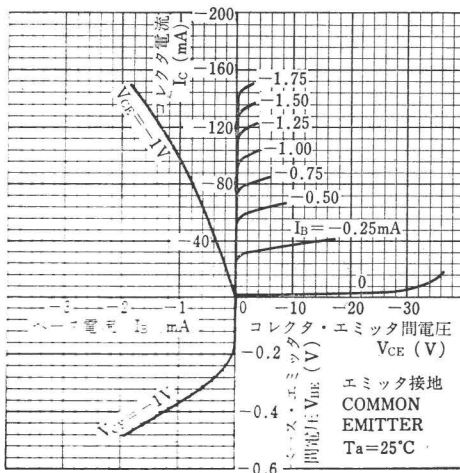
Characteristic	Symbol	Rating	Unit
コレクタ・ベース間電圧	$V_{CBO}$	-30	V
コレクタ・エミッタ間電圧 ( $R_{BE}=10\text{ k}\Omega$ )	$V_{CER}$	-20	V
エミッタ・ベース間電圧	$V_{EBO}$	-12	V
コレクタ電流	$I_C$	-150	mA
エミッタ電流	$I_E$	150	mA
コレクタ損失	$P_C$	150	mW
接合温度	$T_J$	75	°C
保存温度	$T_{stg}$	-55~85	°C



## 電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25°C)

Characteristic	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
コレクタシャ断電流	$I_{CBO}$	$V_{CB}=-30\text{V}, I_E=0$	—	—	-14	$\mu\text{A}$
エミッタシャ断電流	$I_{EBO}$	$V_{EB}=-12\text{V}, I_C=0$	—	—	-14	$\mu\text{A}$
小信号電流増幅率	$h_{fe}$	$V_{CE}=-6\text{V}, I_E=1\text{mA}, f=270\text{Hz}$	80	140	300	
トランジション周波数	$f_T$	$V_{CE}=-6\text{V}, I_E=1\text{mA}$	—	1	—	MHz
コレクタ出力容量	$C_{ob}$	$V_{CB}=-6\text{V}, I_E=0, f=1\text{MHz}$	—	35	—	pF
ベース拡がり抵抗	$r_{bb'}$	$V_{CE}=-6\text{V}, I_E=1\text{mA}, f=6\text{MHz}$	—	120	—	$\Omega$
入力インピーダンス (出力短絡)	$h_{ie}$	$V_{CE}=-6\text{V}, I_E=1.0\text{mA}, f=270\text{Hz}$	—	4.2	—	k $\Omega$
電圧帰還率 (入力開放)	$h_{re}$		—	6	—	$\times 10^{-4}$
小信号電流増幅率 (出力短絡)	$h_{fe}$		—	140	—	
出力アドミタンス (入力開放)	$h_{oe}$		—	30	—	$\mu\text{S}$

## STATIC CHARACTERISTICS



## Pc-Ta

